## **FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS**



Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores

Grupo F Grado Ingeniería Informática Convocatoria de febrero 2016

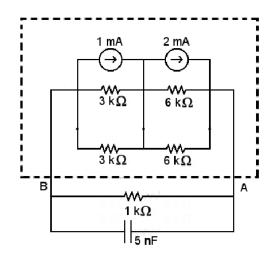
Duración: 3 horas

Responde a cada pregunta en hojas separadas. Indica en cada hoja tu nombre, el número de página y el número de páginas totales que entregas.

Lee detenidamente los enunciados antes de contestar

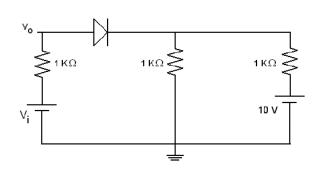
Nombre	D.N.I.	Grupo

1. a) Calcula el equivalente de Thevenin de la parte recuadrada del circuito siguiente (dejando fuera la resistencia de 1 k $\Omega$  y el condensador de 5 nF) visto desde los terminales A y B. (1.5 puntos)

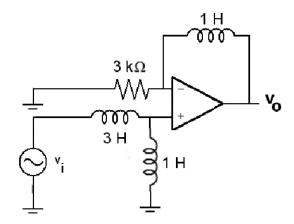


- b) Usando el equivalente de Thevenin del circuito anterior, calcula la diferencia de tensión entre A y B en el circuito completo (1 punto)
- 2.- Calcula y representa la característica de transferencia del siguiente circuito para cualquier valor de tensión de entrada v<sub>i</sub>. (1.5 puntos)

$$V_{v} = 0.6 V$$



- 3.- Implementa usando lógica CMOS una puerta que realice la operación  $\overline{A \cdot (B+C+D)}$  (1 puntos)
- 4.- Para el circuito de la imagen calcula:
- a) La función de transferencia (1.5 puntos)
- b) El módulo y el argumento de la función de transferencia (1 punto)
- c) El valor de la salida para la entrada  $v_i(t) = 4\cos(30t) + 4\cos(3000t + \pi/2)$  V (1 punto)



5.- Calcule la corriente que circula por la resistencia de 2 k $\Omega$ 

## (1.5 puntos)

Datos: k = 2 mA/V<sup>2</sup>;  $V_T$ =1 V

Región lineal u óhmica:

$$I_{D} = \frac{k}{2} \Big[ 2 (V_{GS} - V_{T}) V_{DS} - V_{DS}^{2} \Big]$$

Región de saturación:

$$I_D = \frac{k}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

